ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE

Publication number:	WO2004034751 (A1)		Also published as:
Publication date:	2004-04-22		EP1551206 (A1)
Inventor(s):	ARAKANE TAKASHI [JP]; IWAKUMA TOSHIHIRO [JP]; HOSOKAWA CHISHIO [JP]	包	EP1551206 (A4) US2006257684 (A1)
Applicant(s):	IDEMITSU KOSAN CO [JP]; ARAKANE TAKASHI [JP]; IWAKUMA TOSHIHIRO [JP]; HOSOKAWA CHISHIO [JP]	=	KR20050074478 (A) CN1703937 (A)
Classification:			CN1703937 (A)
- international:	C09K11/06; H01L51/00; H01L51/30; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; C09K11/06; H01L51/00; H01L51/05; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/22; H05B33/14		Cited documents: JP2002352957 (A) JP2003077673 (A)
- European:	H01L51/50J2; C09K11/06; H01L51/00M6D; H01L51/00M6H; H01L51/00M6H14; H01L51/00M12F2; H01L51/50E3; H05B33/14; H05B33/22		JP2002151267 (A) JP2002056976 (A) WO0251206 (A2)
Application number:	WO2003JP12598 20031001	لتا	VVOUZ51200 (AZ)
Priority number(s):	JP20020296024 20021009		more >>

Abstract of WO 2004034751 (A1)

An organic electroluminescent device having, between a cathode and an anode, a light-emitting layer which is made of at least a phosphorescent material and a host material, has an electron injection layer arranged between the light-emitting layer and the cathode and having a junction with the light-emitting layer. The light-emitting layer has electron transport properties and the ionization potential of the host material is 5.9 eV or less. The energy gap of an electron transport material in the electron injection layer is smaller than that of the host material in the light-emitting layer, or the triplet energy of the electron transport material in the electron injection layer is smaller than that of the host material in the light-emitting layer. The organic electroluminescent device uses light emission of phosphorescence and has high luminous efficiency.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年4 月22 日 (22.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/034751 A1

(51) 国際特許分類7:

H05B 33/22, 33/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/012598

(22) 国際出願日:

2003年10月1日(01.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-296024 2002年10月9日(09.10.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 出光興 産株式会社 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-8321 東京都 千代田区 丸の内三丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 荒金 崇士 (ARAKANE,Takashi) [JP/JP]; 〒299-0205 千葉県 袖 ケ浦市 上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP). 岩隈 俊裕 (IWAKUMA, Toshihiro) [JP/JP]; 〒299-0205 千葉県袖ケ浦市 上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP). 細川 地潮 (HOSOKAWA, Chishio) [JP/JP]; 〒299-0205 千葉県袖ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 大谷 保、外(OHTANI, Tamotsu et al.); 〒 105-0001 東京都 港区 虎ノ門三丁目25番2号 ブ リデストン虎ノ門ビル6階 大谷特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE

(54) 発明の名称: 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) Abstract: An organic electroluminescent device having, between a cathode and an anode, a light-emitting layer which is made of at least a phosphorescent material and a host material, has an electron injection layer arranged between the light-emitting layer and the cathode and having a junction with the light-emitting layer. The light-emitting layer has electron transport properties and the ionization potential of the host material is 5.9 eV or less. The energy gap of an electron transport material in the electron injection layer is smaller than that of the host material in the light-emitting layer, or the triplet energy of the electron transport material in the electron injection layer is smaller than that of the host material in the light-emitting layer. The organic electroluminescent device uses light emission of phosphorescence and has high luminous efficiency.

↑ (57) 要約: 陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが5.9 e V以下であり、電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップが、発光層中のホスト材料のエネルギーギャップより小さいか、又は電子注入層中の電子輸送材料の三重項エネルギーが、発光層中のホスト材料の三重項エネルギーより小さい有機エレクトロルミネッセンス素子であり、燐光性の発光を用い、発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。



明細書

有機エレクトロルミネッセンス素子

技術分野

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、特に、燐光性の発光を 利用し、低い駆動電圧で、発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子に 関するものである。

背景技術

有機エレクトロルミネッセンス素子(以下エレクトロルミネッセンスをELと 略記することがある)は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と 陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を 利用した自発光素子である。イーストマン・コダック社のC.W.Tangらに よる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告 (C.W. Tang, S.A. Vansly ke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 5 1巻、9 1 3頁、1987年等)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子 に関する研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキ ノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送 層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高める こと、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生 成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じ込めること等が挙げられ る。この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電 |子輸送発光層の2層型、又は正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入)層 の3層型等がよく知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と 電子の再結合効率を髙めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

有機EL素子の発光材料としてはトリス(8-キノリノラート)アルミニウム 錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらからは青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報等参照)。

また、近年、有機EL素子の発光層に、発光材料の他に有機リン光材料を利用することも提案されている(例えば、D.F.O'Brien and M.A.Baldo et al "Improved energy transferin electrophosphorescent devices" Applied Physics letters Vol. 74 No. 3, pp442-444, January 18, 1999; M.A.Baldo et al "Very high-efficiencygreen organic light-emitting devices based on electrophosphorescence" Applied Physics letters Vol. 75 No. 1, pp4-6, July 5, 1999等参照)。

このように有機EL素子の発光層において、有機リン光材料の励起状態の一重項状態と三重項状態とを利用することにより、高い発光効率が達成されている。有機EL素子内で電子と正孔が再結合する際にはスピン多重度の違いから一重項励起子と三重項励起子とが1:3の割合で生成すると考えられているので、燐光性の発光材料を用いれば蛍光のみを使った素子の3~4倍の発光効率の達成が考えられる。

このような有機EL素子においては、3 重項の励起状態又は3 重項の励起子が 消光しないように順次、陽極、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層(正孔阻止 層)、電子注入層、陰極のように層を積層する構成が用いられてきた(例えば、 米国特許第6,097,147号明細書、国際特許公報WO01/41512号 明細書参照)。この構成を有する有機EL素子には、以下のような特徴があった

①電子注入層と発光層を接合すると、励起状態が消光するため、発光層よりエネ

ルギーギャップが広いか又は発光層の三重項エネルギーより大きな三重項エネル ギーを保有する正孔阻止層を用いた。

②正孔阻止層は有機発光層からの正孔の移動を制限し、正孔を発光層中に効率よく蓄積することによって、電子との再結合確率を向上させることが可能であった

③正孔阻止層と陰極金属を直接接合すると寿命や効率などの性能が著しく低くなるため正孔阻止層と陰極の間にエネルギーギャップが正孔阻止層より小さい電子 注入層を設ける必要があった。

しかしながら、これら従来の電子注入構成には問題があることが判明した。すなわち、正孔阻止層はエネルギーギャップが広く他層からの電荷注入輸送に対してはエネルギー障壁として働き抵抗が大きいため、駆動電圧が上昇した。さらに正孔阻止層に用いられる多くの化合物は、高い正孔阻止能を保有していたが劣化しやすく長寿命な素子を与えることができなかった。

また、従来の素子として、電子注入層と発光層を直接接合し、電子注入層を形成する電子輸送材料の三重項エネルギーを発光層を形成するホスト材料の三重項エネルギーより大きくするようにした素子も知られている(例えば、特開2002-100476号公報)。しかしながら、電子輸送材料の三重項エネルギーを大きくした素子は、消光を免れるものの一重項エネルギーが三重項エネルギーより一般的に0.3eV以上大きいため、結果として電子輸送材料のエネルギーギャップが極めて大きく3eV以上となる。このような場合、陰極からの電子注入のエネルギー障壁は極めて大きく駆動電圧の高電圧化が生じ、またエネルギー障壁が大きいと場合には、電流を注入しつづけると劣化が生じ易く、素子の寿命が短いなどの問題があった。

さらに、発光層のホスト材料を電子輸送材料で形成した素子も知られている。 (例えば、国際特許公報WO01/93642号明細書)。しかしながら、この 素子に用いられたホスト材料はイオン化ポテンシャル5.9eV以上であったた

め、ホスト材料に正孔を注入することができず、ホスト材料が正孔を輸送せず駆 動電圧が高くなるという問題があった。

発明の開示

本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、燐光性の発光を用いた有機EL素子において、低い駆動電圧で、発光効率が高い有機EL素子を提供することを目的とする。

本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、第一の発明 では、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層と陰極との間に 、発光層と接合した電子注入層を設けて正孔阻止層は省略し、さらに、電子注入 層中の電子輸送材料のエネルギーギャップを、発光層中のホスト材料のエネルギ ーギャップより小さくした。当業者の従来の理解では、このようにすることで、 発光層で生じた励起状態が電子注入層により失活し、効率の極めて低い素子しか 得られない。しかし、本発明ではさらに、発光層を電子輸送性とすることにより 、電子と正孔が再結合する領域が電子注入層と発光層との界面から離れ失活が免 れる。さらには、発光層中のホスト材料に良好に正孔が注入できるようにホスト 材料のイオン化ポテンシャルを 5.9 e V以下としたことにより、従来の有機 E L素子のように正孔阻止層を用いずに高効率な素子が得られ、さらに発光層中の ホスト材料に正孔が注入でき輸送できるので駆動電圧を低下させることができ、 劣化しやすい正孔阻止層を用いないので長寿命の素子を得ることができる。また 、有機EL素子の構成が簡素になったため容易に作製可能となった。さらに、エ ネルギーギャップが発光層中のホスト材料のエネルギーギャップより小さい電子 輸送材料を含有させたため、陰極からの電子注入が促進される効果もあり、低電 圧化の効果もあることが確認された。

また、第二の発明では、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を設け、電子注入層中の電子

輸送材料の三重項エネルギーを、発光層中のホスト材料の三重項エネルギーより 小さくした。これにより、電子輸送材料のエネルギーギャップを狭くし、陰極からの電子注入を良好とすることが可能となる。当業者の従来の理解では、このようにすることで、発光層で生じた励起状態が電子注入層により失活し、効率の極めて低い素子しか得られない。しかし、本発明ではさらに、発光層を電子輸送性とすることにより、電子と正孔が再結合する領域が電子注入層と発光層との界面から離れ失活が免れる。さらには、発光層中のホスト材料に良好に正孔が注入できるようにホスト材料のイオン化ポテンシャルを5.9 e V以下としたことにより、従来の有機BL素子と異なり、エネルギーギャップが広い電子注入層を用いずに高効率な素子を得ることが可能になり、電子注入のエネルギー障壁を小さくした効果として素子の寿命が改善された。さらに発光層中のホスト材料に正孔が注入でき輸送できるので駆動電圧を低下させることができる。また、有機EL素子の構成が簡素になったため容易に作製可能となった。

すなわち、本第一発明は、陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機EL素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが 5.9 e V以下であり、電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップが、発光層中のホスト材料のエネルギーギャップより小さいことを特徴とする有機EL素子を提供するものである。

また、本第二発明は、陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機EL素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが 5.9 e V以下であり、電子注入層中の電子輸送材料の三重項エネルギーが、発光層中のホスト材料の三重項エネルギーより小さいことを特徴とする有機EL素子を提供するものである。

前述のように、本第一発明及び本第二発明(以下、本発明)においては、発光

層が電子輸送性であることが必須であるが、本発明で電子輸送性であるとは、下記(1)又は(2)のいずれかであることをいう。

- (1)発光層中のホスト材料の電子移動度が 10^{-6} c m² / V s 以上(好ましくは、 10^{-6} c m² / V s 以上)である化合物である。電子移動度に関しては飛行時間法(TOF)又は空間電荷制限電流の過渡測定により計測することができる。TOF 法については、シンセティック メタルズ(Synth. Met.)111/112, (2000) 331頁に記載され、空間電荷制限電流の過渡測定については、Electrical Transport in Solids, Pergamon Press, 1981年、第<math>346~348頁の記載がある。
- (2)発光層の陽極側の領域における正孔と電子の再結合が陰極側における再結合より多い。これは発光層の領域を2分して、(陰極/電子注入層/陰極側発光層/陽極側発光層/正孔輸送層/陽極側)という層構成とした場合において、陽極側発光層のみに燐光発光性化合物を添加した素子ANと陰極側発光層のみに燐光発光性化合物を添加した素子ANの方が再結合が大きい場合に相当する。その際、電子注入層や正孔輸送層により発光層の励起状態が消光しない様に留意すべきである。また、発光層の陽極側界面のみに燐光発光性化合物を添加した素子AN'と陰極側界面のみに燐光発光性化合物を添加した素子AN'と陰極側界面のみに燐光発光性化合物を添加した素子CA'の効率を比較して素子AN'の効率が大きい場合に発光層は電子輸送性であると言える。

なお、本発明における電子輸送性とは正孔輸送性がないことを意味しない。したがって電子輸送性であるが、正孔移動度を計測した際、 $10^{-7}\,\mathrm{cm^2}/\mathrm{Vs}$ り大きい値を保有していても問題ない。

本発明の有機EL素子において、還元性ドーパントが、電子注入層に添加されているか、又は陰極と該陰極と接合する層との界面領域に添加されていると好ましい。このようにすることで素子の電圧を低くすることができる。

本発明の有機EL素子において、陰極と陽極間に、燐光性の発光材料が添加されている正孔輸送層を有すると好ましい。このようにすることで正孔輸送層で生

じた励起状態も発光につながり一段と発光効率が高くなる。

また、前記正孔輸送層中の正孔輸送材料の三重項エネルギーが、前記発光層中の燐光性の発光材料の励起エネルギーより大きいと好ましい。このようにすることで、正孔輸送材料により発光層の励起状態が消光しなくなり一段と発光効率が高くなる。

発明を実施するための最良の形態

本第一発明の有機EL素子は、陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機EL素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが5.9eV以下(好ましくは、5.8eV以下であり)であり、電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップが、発光層中のホスト材料のエネルギーギャップより小さい。

本第二発明の有機EL素子は、陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機EL素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが 5.9 e V以下であり(好ましくは、5.8 e V以下であり)、電子注入層中の電子輸送材料の三重項エネルギーが、発光層中のホスト材料の三重項エネルギーより小さい。

前記発光層中のホスト材料が電子輸送性であると好ましく、このホスト材料の電子輸送度は 10^{-6} c m^2 / V s 以上であると好ましい。

発光層中のホスト材料については、従来から用いられてきたポリビニルカルバ ゾールやビスカルバゾゾールなどのポリカルバゾール化合物は、例外的な場合を 除き正孔輸送性でありかつ電子の輸送能力は小さい。このような正孔輸送性材料 をホスト材料として用いた際には、発光層の陰極側界面が主たる再結合領域とな る。この時、発光層と陰極の間に電子注入層を介在させる共に電子注入層と発光

層を接合させ、電子注入層にエネルギーギャップが発光層を形成するエネルギーギャップより小さい電子輸送材料を含有させると、発光層の陰極側界面を中心として生じた励起状態が電子注入層により失活し、効率の極めて低い素子しか得られない。また、電子注入層を形成する電子輸送材料の三重項エネルギーは発光層を形成するホスト材料の三重項エネルギーより小さい場合でも発光層の陰極側界面を中心として生じた励起状態が電子注入層により失活し、効率の極めて低い素子しか得られない。

一方、本発明では発光層が電子輸送性であるため、電子と正孔が再結合する領域が電子注入層と発光層との界面から離れ、生じた励起状態の失活を免れる。

また、本発明の発光層中のホスト材料は、イオン化ポテンシャルが 5.9eV以下のものである。このようにすることにより、正孔輸送材料のイオン化ポテンシャルが $5.3\sim5.7eV$ であることから、エネルギー障壁を $-0.2\sim0.6eV$ とすることができホスト材料へ正孔が注入できるようになる。さらに、ホスト材料間で正孔が輸送されるようになるので、駆動電圧が低くなるような化合物を使用することもできる。

前記発光層中のホスト材料としては、カルバゾリル基もしくはアザカルバゾリル基が含窒素環に連結した化合物、又はカルバゾリル基もしくはアザカルバゾリル基がアリーレン基を介して含窒素環に連結した化合物であると好ましい。

このカルバゾリル基、アザカルバゾリル基、含窒素環及びアリーレン基は、それぞれ置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水素基、芳香族複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アルコシキカルボニル基、カルボキシル基等が挙げられる。

また、前記発光層中のホスト材料としてさらに好ましくは、下記一般式(1) 又は(2)で表される化合物である。

$$(Cz-)_{m}A$$
 (1)

(式中、Czは、置換もしくは無置換のカルパゾリル基、又は置換もしくは無置換のアザカルパゾリル基である。Aは、アリール置換含窒素環基、ジアリール置換含窒素環基、又はトリアリール置換含窒素環基である。mは1~3の整数である。)

$$Cz-A_n$$
 (2)

(式中、Czは、置換もしくは無置換のカルバゾリル基、又は置換もしくは無置換のアザカルバゾリル基である。Aは、アリール置換含窒素環基、ジアリール置換含窒素環基、又はトリアリール置換含窒素環基である。nは1~3の整数である。)

前記ホスト材料における好ましい含窒素環としては、ピリジン、キノリン、ピ ラジン、ピリミジン、キノキサリン、トリアジン、イミダゾール、イミダゾピリ ジン、ピリダジン、ベンズイミダゾール等が挙げられる。

また、一般式(1)及び(2)においては、Czの部位でイオン化ポテンシャルの値は $5.6eV \sim 5.8eV$ であることが判明している。

本発明の有機 E L 素子において、発光層中に含まれる燐光性の発光材料としては、素子の外部量子効率をより向上させることができる点で有機金属錯体が好ましく、有機金属錯体の金属原子として、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、金を含有するものが挙げられる。これらの有機金属錯体は下記一般式(3)で表される有機金属錯体であるのが好ましい。

$$\begin{bmatrix} A^1 \\ C \\ C \\ A^2 \end{bmatrix}_{n}$$
 (3)

(式中、A'は、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環基を表し、好ましくは、フェニル基、ピフェニル基、ナフチル基、アントリル基、チエニル基、ピリジル基、キノリル基、イソキノリル基であり、前記置換基としては、フッ素原子等のハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~30のアルキル基;ビニル基等のアルケニル基;メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~30のアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~30のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基、アセチル基等のアシル基、トリフルオロメチル基等のハロアルキル基、シアノ基を表す。

A² は、窒素を複素環を形成する原子として含有する置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表し、好ましくは、ピリジル基、ピリミジル基、ピラジン基、トリアジン基、ベンゾチアゾール基、ベンゾオキサゾール基、ベンゾイミダゾール基、キノリル基、イソキノリル基、キノキサリン基、フェナントリジン基であり、前記置換基としては、A¹ と同様のものが挙げられる。

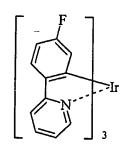
A¹を含む環とA²を含む環は一つの縮合環を形成してもよく、このようなものとしては、例えば、7.8-ベンゾキノリン基等が挙げられる。

Qは、周期表 7~11族から選ばれる金属であり、好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、金を表す。

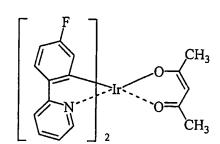
Lは、2座型の配子を表し、好ましくは、アセチルアセトナート等のβ-ジケト型の配位子又はピロメリット酸から選ばれる。

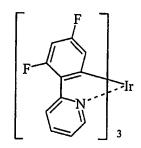
m及vnは整数を表し、vの次二価金属の場合は、v0であり、v0が三価金属の場合は、v1のであり、v2が三価金属の場合は、v1のであり、v2が一三価金属の場合は、v2のであり、v3のであり、v3のであり、v4のであり、v5のであり、v6のであり、v7のであり、v8のであり、v9のでのののののの

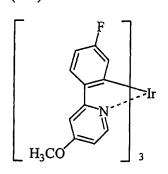
前記一般式(3)で示される有機金属錯体の具体例を以下に示すが、何ら下記 の化合物に限定されるものではない。



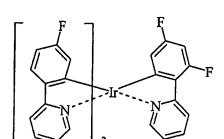
(K-2)



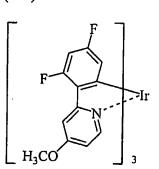


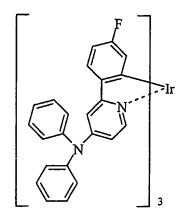


(K-5)



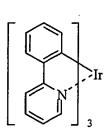
(K-6)

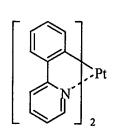




(K-8)

(K-9)





(K-17)

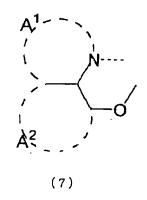
本発明の電子注入層に用いる電子輸送材料は、前述したように、電子輸送材料のエネルギーギャップが発光層中のホスト材料より小さいか、又は電子輸送材料の三重項エネルギーが発光層中のホスト材料より小さくしたことにより、電子注入性が向上している。

電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップは、2.8 e V以下であると好ましく、2.75 e V以下であるとさらに好ましい。好ましい電子輸送材料としては、含窒素複素環化合物が挙げられる。これは、窒素原子を有する複素環を有する化合物と定義され、例えば、含窒素錯体や含窒素環化合物が挙げられる

含窒素錯体としては下記(4)~(6)のいずれかで表される化合物が好ましい。

- (4) M⁺ Q又はM⁺ Q' (式中、M⁺ は一価金属イオン)
- (5) M²⁺Q₂、M²⁺QQ'又はM²⁺Q'₂(式中、M²⁺は二価金属イオン)
- (6) M³+Q₃、M³+Q₂Q'₂又はM³+Q'₃(式中、M³+は三価金 属イオン)

ここで、Q及びQ'は、それぞれ独立に、下記一般式 (7) 及び (8a) ~ (8c) で表される配位子である。



(式中、A¹及びA²は、置換もしくは無置換の芳香族環である)

$$-O-Ar^{7}$$
 (8a) $-O-C-Ar^{8}$ (8b) $-O-Z-Ar^{10}$ (8c)

(式中、ZはSi、Ge ZはSn のいずれかの原子を表わし、Ar 1 \sim Ar 10 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表す)

また、Q及びQ'は、それぞれベンゾアゾールであってもよく、例えば、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール誘導体等があげられる

これらのうち、特に好ましいQ及びQ'は、下記一般式(9)で表されるものである。

$$R_3$$
 R_2 N_{--} R_5 R_6 R_7 R_7

(式中、 $R_2 \sim R_7$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアカルギール基、又はカルボキシル基を表す。 $R_2 \sim R_7$ は、それらのうちの2つで環を形成していてもよい。)

前記 $R_2 \sim R_1$ の示す各基の具体例としては、以下に示すようなものが挙げられる。

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

置換もしくは無置換のアミノ基は-NX'X'と表され、X'及びX'の例と しては、それぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ ロピル基、n-プチル基、s-プチル基、イソプチル基、t-ブチル基、n-ペ ンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチ ル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソ プチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル 基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピ ル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロ イソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、 2, 3-ジクロロー t ープチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモ メチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基 、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブ ロモー t ーブチル基、1, 2, 3 ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジ ヨードエチル基、1,3ージョードイソプロピル基、2.3ージョードーtーブ チル基、1,2,3ートリヨードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチ ル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソプチル基、1.2ージアミノエチル 基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1, 2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シ アノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1.3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノーt-ブチル基、1,2,3-トリ シアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基 、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソ

プロピル基、2、3-ジニトローt-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピ ル基、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ー アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1 ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、4ースチリルフ ェニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニル イル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4 -イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m - ターフェニルー 4 ーイル基、m - ターフェニルー 3 ーイル基、m - ターフェニ ルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチル フェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフ チル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"ーt-プチルーpーターフェニルー4ーイル基、 2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリ ジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-イン ドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソ インドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインド リル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フ リル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基 、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基 、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラ ニル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、 6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4ーイソキノリル基、5ーイソキノリル基、6ーイソキノリル 基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリル基、2ーキノキサリニル基、5ーキ

ノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリ ル基、3ーカルバゾリル基、4ーカルバゾリル基、1ーフェナンスリジニル基、 2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニ ル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンス リジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-ア クリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基 、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェ ナンスロリンー3ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、1,7ー フェナンスロリンー5ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1, 7ーフェナンスロリンー8ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー9ーイル基、 1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4 ーイル基、1,8ーフェナンスロリン-5ーイル基、1,8ーフェナンスロリン - 6 - イル基、1,8 - フェナンスロリン- 7 - イル基、1,8 - フェナンスロ リン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナ ンスロリンー2ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,9ーフ ェナンスロリンー 4 ーイル基、1 , 9 ーフェナンスロリンー 5 ーイル基、1 , 9ーフェナンスロリンー6ーイル基、1.9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1 , 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル 基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリンー 3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンス ロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナ ンスロリンー 3 ーイル基、2, 9 ーフェナンスロリンー 4 ーイル基、2, 9 ーフ ェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9 ーフェナンスロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2 , 9-フェナンスロリン-10-イル基、2.8-フェナンスロリン-1-イル

基、2、8-フェナンスロリン-3-イル基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、2、8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2.8-フェナンスロリン-7-イル基、2.8-フェナンスロリ ン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリンー1ーイル基、2.7ーフェナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェ ナンスロリンー4ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,7ー フェナンスロリンー6-イル基、2.7-フェナンスロリンー8-イル基、2, 7ーフェナンスロリンー9ーイル基、2.7ーフェナンスロリンー10ーイル基 、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フ ェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フ ェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フ ェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリ ル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、 2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチ ルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロー ルー5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、 2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチルー1 - インドリル基、4 - メチルー1 - インドリル基 、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-プ チル1-インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒ

ドロキシイソプチル基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジヒドロキシ イソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒド ロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基 、 2 - クロロイソプチル基、 1 . 2 - ジクロロエチル基、 1 . 3 - ジクロロイソ プロピル基、2.3-ジクロローt-ブチル基、1.2,3-トリクロロプロピ ル基、プロモメチル基、1ープロモエチル基、2ープロモエチル基、2ープロモ イソブチル基、1.2-ジブロモエチル基、1.3-ジブロモイソプロピル基、 2, 3-ジプロモーtープチル基、1, 2, 3-トリプロモプロピル基、ヨード メチル基、1ーヨードエチル基、2ーヨードエチル基、2ーヨードイソプチル基 、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョ ードーtーブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1 ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1,2ージ アミノエチル基、1.3-ジアミノイソプロピル基、2.3-ジアミノーt-ブ チル基、1.2.3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチ ル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソプチル基、1,2-ジシアノエチル 基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノーtーブチル基、1, 2. 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニ トロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローt-ブチル基、1,2,3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルケニル基の例としては、ビニル基、アリル基、1ープテニル基、2ープテニル基、3ープテニル基、1,3ープタンジエニル基、1ーメチルビニル基、スチリル基、2,2ージフェニルビニル基、1,2ージフェニルビニル基、1ーメチルアリル基、1,1ージメチルアリル基、2ーメチルアリル基、1ーフェニルアリル基、3,3ージフェニルアリル基、1,2ージメチルアリル基、1ーフェニルー1

ープテニル基、3ーフェニルー1ープテニル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のシクロアルキル基の例としては、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4ーメチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアルコキシ基は、一〇丫で表される基であり、Yの例と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s ープチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、n-ヘキシル基、 n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロ キシエチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ージヒドロキシー t-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1,2-ジク ロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロローtーブチ ル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル 基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基 、1,3-ジプロモイソプロピル基、2,3-ジプロモーtープチル基、1,2 , 3ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨードエチル基、2ーヨー ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジ ヨードイソプロピル基、2,3-ジョードーt-ブチル基、1,2,3-トリョ ードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、 2-アミノイソプチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプ ロピル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル 基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイ ソプチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2 , 3-ジシアノーtーブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメ チル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、

1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロー t-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基の例としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、4ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、2ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、3ーピフェニルイル基、4ーピフェニルイル基、カーターフェニルイル基、pーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、pートリル基、mートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、1ープチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4・メチルビフェニルイル基、4"ーtーブチルーpーターフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換の芳香族複素環基の例としては、1ーピロリル基、2ーピロリル基、3ーピリジニル基、2ーピリジニル基、3ーピリジニル基、4ーピリジニル基、1ーインドリル基、2ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、4ーイソインドリル基、5ーイソインドリル基、6ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、5ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、3ーイソインドリル基、1ーイソインゾフラニル基、6ーインゾフラニル基、7ーベンゾフラニル基、1ーイソベンゾフラニル基、3ーイソベンゾフラニル基、4ーイソベンゾフラニル基、5ーイソベンゾフラニル基、6ーイソベンゾフラニル基、7ーイソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基

、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基、8ーキ ノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリ ル基、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニル基、 1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾ リル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジ ニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナン スリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フ ェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル 基、1、7-フェナンスロリン-2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3-イル基、1.7-フェナンスロリン-4-イル基、1.7-フェナンスロリンー 5-イル基、1.7-フェナンスロリン-6-イル基、1.7-フェナンスロリ ン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンス ロリンー 10 ーイル基、1.8ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,8ーフェ ナンスロリンー3ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー4ーイル基、1,8ー フェナンスロリンー5ーイル基、1,8-フェナンスロリンー6ーイル基、1, 8-フェナンスロリンー7ーイル基、1,8-フェナンスロリンー9ーイル基、 1.8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4 ーイル基、1.9ーフェナンスロリン-5ーイル基、1.9ーフェナンスロリン - 6 ーイル基、1, 9 ーフェナンスロリンー 7 ーイル基、1, 9 ーフェナンスロ リン-8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン-10 - イル基、1, 10 - フェ ナンスロリンー 2 ーイル基、1 , 1 0 ーフェナンスロリンー 3 ーイル基、1 , 10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基

ル基、2,9ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー5 ーイル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロリン - 7 - イル基、 2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、 2, 9 - フェナンスロ リン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナ ンスロリンー3-イル基、2.8-フェナンスロリン-4-イル基、2.8-フ ェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8 ーフェナンスロリンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー9ーイル基、2 ,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル 基、2, 7-フェナンスロリンー3-イル基、2, 7-フェナンスロリンー4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリ ンー9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル 基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、 3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基 、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基 、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキ サジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メ チルピロールー1ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロ ールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1 ーイル基、3ーメチルピロールー2ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基 、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3 - (2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリ ル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、4ーメ チルー3ーインドリル基、2-t-プチル1-インドリル基、4-t-ブチル1 ーインドリル基、2-tープチル3-インドリル基、4-tープチル3-インド

リル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1-フェニル エチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニルーtープチル基、αーナフチルメチル基、1-αーナ フチルエチル基、 $2-\alpha-$ ナフチルエチル基、 $1-\alpha-$ ナフチルイソプロピル基 、 $2-\alpha-t$ フチルイソプロピル基、 $\beta-t$ フチルメチル基、 $1-\beta-t$ フチル エチル基、2-β-ナフチルエチル基、1-β-ナフチルイソプロピル基、2β-ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エ チル基、pーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、oーメチルベンジル基 、p-クロロベンジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-ブロモベンジル基、mープロモベンジル基、oープロモベンジル基、pーヨード ベンジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベ ンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキシベンジル基、p-アミノ ベンジル基、m-アミノベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジ ル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シアノベンジル基、 m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニル イソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

置換もしくは無置換のアリールオキシ基は、-OZ'と表され、Z'の例としてはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、2ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、3ーピフェニルイル基、4ーピフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、cートリル

基、mートリル基、pートリル基、pーtープチルフェニル基、pー(2-フェ ニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナ フチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4 "ーt-ブチル-p-ターフェニルー4ーイル基、2-ピロリル基、3-ピロリ ル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基 、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基 、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソイン ドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル 基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル 基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6 ーベンゾフラニル基、7ーベンゾフラニル基、1ーイソベンゾフラニル基、3ー イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基 、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3 ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリ ル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキ ノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8 ーイソキノリル基、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキ サリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、 4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、 3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニ ル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンス リジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジ ニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7−フェナンスロリン−2−イル基、1,7−フェナンスロリン−3−イル基、 1. 7-フェナンスロリン-4-イル基、1. 7-フェナンスロリン-5-イル 基、1.7-フェナンスロリンー6-イル基、1.7-フェナンスロリンー8-

イル基、1.7-フェナンスロリンー9-イル基、1,7-フェナンスロリンー 10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロ リン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナン スロリンー5-イル基、1.8-フェナンスロリンー6-イル基、1,8-フェ ナンスロリンー 7 ーイル基、1,8 ーフェナンスロリンー 9 ーイル基、1,8 ー フェナンスロリンー10ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー2ーイル基、1 . 9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基 $x_1, y_1 - y_2 + y_3 - y_4 - y_5 - y_6 - y_7 - y_7$ ル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8 ーイル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロ リン-2 - イル基、1、10 - フェナンスロリン-3 - イル基、1, 10 - フェ ナンスロリンー4-4ル基、1.10-フェナンスロリンー5-4ル基、2,9 ーフェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2 . 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基 x_1 、2,9-フェナンスロリンー6-イル基、2,9-フェナンスロリンー7ーイ ル基、2.9-フェナンスロリン-8-イル基、2.9-フェナンスロリン-1 0-イル基、2.8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリ ンー3ーイル基、2.8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,8ーフェナンス ロリンー5-イル基、2.8-フェナンスロリンー6-イル基、2,8-フェナ ンスロリンー 7 ーイル基、2, 8 ーフェナンスロリンー 9 ーイル基、2, 8 ーフ ェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンスロリンー3-イル基、2.7-フェナンスロリンー4-イル基、 2. 7-フェナンスロリン-5-イル基、2. 7-フェナンスロリン-6-イル 基、2,7-フェナンスロリンー8-イル基、2,7-フェナンスロリンー9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェ

ノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-オチルピロールー4-イル基、3-インドリル基、4-オチルー3-インドリル基、4-オチルー3-インドリル基、4-オープチル1-インドリル基、2-オープチル1-インドリル基、4-オープチル3-インドリル基等が挙げられる。

ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョードーセーブチル基、1,2,3-トリョードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソプロピル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-トリアミノプロピル基、2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソプチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノーセーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、2-ニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローセーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

また、環を形成する場合の2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2,2'ージイル基、ジフェニルエタン-3,3'ージイル基、ジフェニルプロパン-4,4'ージイル基等が挙げられる。

前記各置換基としては、例えば、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水素基、芳香族複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アルコシキカルボニル基、又はカルボキシル基等が挙げられ、具体例としては前記と同様のものが挙げられる。

以上のうち、特に好ましい電子輸送材料の含窒素錯体としては、単一の種類の含窒素環誘導体が配位した金属錯体であり、前記含窒素環が、キノリン、フェニルピリジン、ベンゾキノリン又はフェナントロリンであると好ましい。また、前記金属錯体が、キノリノールの金属錯体又はその誘導体であると好ましい。具体的には8-キノリノール誘導体を配位子とする金属錯体、例えばトリス(8-キノリノール) A 1 錯体、トリス(5,7-ジクロロ-8-キノリノール) A 1 錯

体、トリス(5,7ージプロモー8ーキノリノール) A 1 錯体、トリス(2ーメチルー8ーキノリノール) A 1 錯体、トリス(5ーメチルー8ーキノリノール) A 1 錯体、トリス(8ーキノリノール) I n 錯体、トリス(8ーキノリノール) M g 錯体、トリス(8ーキノリノール) C u 錯体、トリス(8ーキノリノール) C a 錯体、トリス(8ーキノリノール) S n 錯体、トリス(8ーキノリノール) G a 錯体、トリス(8ーキノリノール) P b 錯体等の1種単独または2種以上の組み合わせが挙げられる。

これらの金属錯体は、エネルギーギャップが小さいので陰極からの電子注入性に優れ、電子輸送に対する耐久性も高く、長寿命の素子を与えることができる。

また、好ましい電子輸送材料の含窒素環化合物としては、含窒素環としてピリジン、キノリン、ピラジン、ピリミジン、キノキサリン、トリアジン、イミダゾール、イミダゾピリジン等を有する化合物が挙げられ、特にエネルギーギャップを小さくできることから含窒素環と縮合芳香族環が連結した化合物、又は含窒素環がアリーレン基を介して縮合芳香族環と連結した化合物が好ましい。この含窒素環、縮合芳香族環及びアリーレン基は、それぞれ置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水素基、芳香族複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アルコシキカルボニル基、カルボキシル基等が挙げられる。

また、好ましい前記縮合芳香族環としては、ナフタレン、アントラセン、ピレン、フェナントレン、フルオランテン、クリセン、ペリレン、ナフタセン又はペンタセン等が挙げられる。

さらに好ましい電子輸送材料の含窒素環化合物としては、含窒素環が、イミダゾールや、これを縮環させたイミダゾピリジン、ベンゾイミダゾール等の6員環と5員環の縮合環であって、1~4個の窒素原子を有するものであり、例えば、ベンゾイミダゾール構造を有するものとして、例えば下記一般式(A)~(B)

で表されるものが挙げられる。

$$(A) \qquad (B)$$

一般式(A)及び(B)中、Lは一価又は二価の連結基を表し、例えば、炭素、ケイ素、窒素、ホウ素、酸素、硫黄、金属(例えば、バリウム、ベリリウム)、芳香族炭化水素環、芳香族複素環等が挙げられ、これらのうち炭素原子、窒素原子、ケイ素原子、ホウ素原子、酸素原子、硫黄原子、芳香族炭化水素基、芳香族複素基が好ましく、炭素原子、ケイ素原子、芳香族炭化水素基、芳香族複素基がさらに好ましい。

Lの芳香族炭化水素基及び芳香族複素基は置換基を有していてもよく、置換基として好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、芳香族炭化水素基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニルンを、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルカニルを、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、さらに好ましくはアルキル基、アリールオキシ基、アリール基、芳香族複素環基である。

また、一般式(A)及び(B)において、Lが一価の場合、Lは-L'-Ar '-Ar'で表され、L'、Ar'、Ar'としては、縮合芳香族環であるアン

一般式(A)及び(B)で表される化合物の具体例としては、以下の例示化合物等が挙げられるがこれら例示化合物に限定されるものではない。なお、下記例示において、一般式(A)及び(B)における()内の含窒素環残基の部分はHArと記載している。

3 4

$$HAr - L' - Ar^{1} - Ar^{2}$$

	HAr	L'	Ar.1	Ar ²
(A-15)	H ₂ C			
(A-16)	Ei, N	Q		
(A-17)	H ₃ C N			
(A-18)	H ₃ C-ON	Q		\Box
(A-19)	H ₃ C N			
(A-20)	CH ₃			
(A-21)		Q		
(A-22)				
(A-23)				

HAr-L'-Ar¹ -Ar²

HA r - L'- A r 1 - A r 2

	Г	IAI-L-A	Ar - Ar	
	HAr	L'	Ar ¹	Ar ²
(A-36)		Q	СН	
(A-37)				
(A-38)				
(A-39)			H ₃ C CH ₃	
(A-40)				
(A-41)				
(B-1)				
(B-2)				
(B-3)		Q		\Leftrightarrow

Lが二価の場合、一般式(A)及び(B)はHAr-L'-Ar'-L'-HArで表されるものが好ましい。L'及びAr'の例は及び好ましい例は前記と同様であり、置換基を有していてもよく,L'は単結合でもよい。

R及びR'は、それぞれ水素原子、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は 複素環基を表す。

R及びR'の脂肪族炭化水素基は、直鎖、分岐又は環状のアルキル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8のアルキル基であり、例えば、メチル、エチル、isoープロピル、tertーブチル、nーオクチル、nーデシル、nーへキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロペキシル等が挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8のアルケニル基であり、例えば、ビニル、アリル、2ープテニル、3ーペンテニル等が挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル、3ーペンチニル等が挙げられる。)であり、アルキル基であると好ましい。

R及びR'の芳香族炭化水素基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数 $6 \sim 30$ 、より好ましくは炭素数 $6 \sim 20$ 、さらに好ましくは炭素数 $6 \sim 120$ 芳香族炭化水素基であり、例えば、フェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニル、2-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチルフェニル、ペンタフルオロフェニル、1-ナフチル、2-ナフチル等が挙げられる。

R及びR'の複素環基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ 、さらに好ましくは炭素数 $2 \sim 10$ の複素環基であり、好ましくは窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも一つを含む芳香族へテロ環基である。この複素環基の例としては、例えば、ピロリ

ジン、ピペリジン、ピペラジン、モルフォリン、チオフェン、セレノフェン、フラン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾール、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、テトラゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザインデン、カルバゾール、アゼピン等が挙げられ、好ましくは、フラン、チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノリンであり、さらに好ましくはキノリンである。

R及びR'で表される脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基及び複素環基は置換基を有していてもよく、置換基としては前記しで表される基の置換基として挙げたものと同様であり、また好ましい置換基も同様である。

R及びR'として好ましくは、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基であり、より好ましくは脂肪族炭化水素基(好ましくは炭素数 $6 \sim 30$ 、より好ましくは炭素数 $6 \sim 20$ 、さらに好ましくは炭素数 $6 \sim 12$ のもの)又は芳香族炭化水素基であり、さらに好ましくは脂肪族炭化水素基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ 、さらに好ましくは炭素数 $2 \sim 10$ のもの)である。

nは、1~2の整数である。

また、電子輸送材料の含窒素環化合物におけるイミダゾピリジン構造を有する ものとして、例えば下記一般式(C)で表されるものが挙げられる。

$$Ar^{1}$$
 L^{1} Ar^{2} C

一般式(C)において、Ar'は、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim60$ の(好ましくは核炭素数 $6\sim40$)アリール基、又は置換もしくは無置換の核炭素数 $3\sim60$ (好ましくは核炭素数 $3\sim40$)のヘテロアリール基である。

Ar"の置換もしくは無置換のアリール基の例としては、フェニル基、1-ナ フチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アント リル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基 、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナ フタセニル基、9ーナフタセニル基、1ークリセニル基、2ークリセニル基、6 ークリセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフ ェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニ ルー 4 ーイル基、p ーターフェニルー 3 ーイル基、p ーターフェニルー 2 ーイル 基、m-ターフェニルー4ーイル基、m-ターフェニルー3ーイル基、m-ター フェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtー ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2 ーナフチ ル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基 、4'ーメチルビフェニルイル基、4"ーtープチルーp-ターフェニルー4-イル基、フルオランテニル基、フルオレニル基、スピロビフルオレンからなる1 価の基、パーフルオロフェニル基、パーフルオロナフチル基、パーフルオロアン トリル基、パーフルオロビフェニルイル基、9-フェニルアントラセンからなる 1価の基、9-(1'-ナフチル)アントラセンからなる1価の基、9-(2' ーナフチル)アントラセンからなる1価の基、6-フェニルクリセンからなる1 価の基、9-[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]アントラセンからなる1価

の基等が挙げられ、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル基、 9-(10-フェニル)アントリル基、9-[10-(1'-ナフチル)]アントリル基、9-[10-(2'-ナフチル)]アントリル基等が好ましい。

Ar"の置換もしくは無置換のヘテロアリール基の例としては、ピローリル基、フリル基、チエニル基、シローリル基、ピリジル基、キノリル基、イソキノリル基、ベンゾフリル基、イミダゾリル基、ピリミジル基、カルパゾリル基、セレノフェニル基、オキサジアゾリル基、トリアゾーリル基等が挙げられ、ピリジル基、キノリル基、イソキノリル基が好ましい。

一般式(C)において、 Ar^2 は、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim60$ (好ましくは核炭素数 $6\sim40$)のアリール基、置換もしくは無置換の 核炭素数 $3\sim60$ (好ましくは核炭素数 $3\sim40$)のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim20$ (好ましくは炭素数 $1\sim6$)のアルキル基、又は 置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim20$ (好ましくは炭素数 $1\sim6$)のアルコキシ 基である。

Ar²の置換もしくは無置換のアリール基の例としては、前記Ar'と同様のものが挙げられる。

 $A r^2$ の置換もしくは無置換のヘテロアリール基の例としては、前記A r' と同様のものが挙げられる。

Ar²の置換もしくは無置換のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sープチル基、イソプチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーペキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソプチル基、1,2ージヒドロキシエチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ージヒドロキシーtーブチル基、1,2,3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロエチル基、1,3ージク

ロロイソプロピル基、2,3-ジクロローtープチル基、1,2,3-トリクロ ロプロピル基、ブロモメチル基、1ープロモエチル基、2ープロモエチル基、2 ープロモイソプチル基、1,2ージプロモエチル基、1,3ージプロモイソプロ ピル基、2,3ージブロモーtーブチル基、1,2,3ートリプロモプロピル基 、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソ ブチル基、1,2ージョードエチル基、1,3ージョードイソプロピル基、2, 3ージョードーtーブチル基、1,2,3ートリョードプロピル基、アミノメチ ル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1 ,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 - シ アノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1.2-ジシア ノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノーt-ブチル 基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基 、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、 1.3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローtーブチル基、1,2, 3-トリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基、4ーメチルシクロヘキシル基、1ーアダマンチル基、 2-アダマンチル基、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基等が挙げられ、 、メチル基、エチル基、t-ブチル基が好ましい。

 Ar^{2} の置換もしくは無置換のアルコキシ基は-OYで表される基であり、Yの例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチルを

、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1.2 ージクロロエチル基、1、3ージクロロイソプロピル基、2、3ージクロロー t ープチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモ エチル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソブチル基、1,2-ジプロモエ チル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、 1.2,3-トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、 2-ヨードエチル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジョードエチル基、1 ,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョードーt-ブチル基、1,2,3 ートリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエ チル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミ ノイソプロピル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリアミノ プロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピ ル基、2,3ージシアノーtーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、 ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブ チル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3 ージニトローtーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられ、 、メチル基、エチル基、t-プチル基が好ましい。

ただし、一般式(C)において、Ar'及びAr'のいずれか一方は、置換もしくは無置換の核炭素数 $10\sim60$ の縮合環基、又は置換もしくは無置換の核炭素数 $3\sim60$ のモノヘテロ縮合環基である。

一般式(C)の L^1 及び L^2 は、それぞれ独立に、単結合、置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim 6$ 0(好ましくは核炭素数 $6\sim 4$ 0)のアリーレン基、置換もしくは無置換の核炭素数 $3\sim 6$ 0(好ましくは核炭素数 $3\sim 4$ 0)のヘテロアリーレン基、又は置換もしくは無置換のフルオレニレン基である。

L'及びL'の置換もしくは無置換のアリーレン基の例としては、前記Ar'

と同様のアリール基からさらに水素原子を除き2価の基としたものが挙げられる

 L^1 及び L^2 の置換もしくは無置換のヘテロアリーレン基の例としては、前記 Ar^1 と同様のヘテロアリール基からさらに水素原子を除き 2 価の基としたもの が挙げられる。

また、一般式 (C) において、 L^1 及び/又は L^2 が、

からなる群から選ばれる基であると好ましい。

さらに、一般式(C)において、前記Ar'が、下記一般式(a)~(j)で表される基であると好ましい。

(式中、式中、 R^1 ~ R^9 2は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 4 0 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 1 2 ~ 1 8 0 のジアリールアミノ基、置換もしくは無置換の核炭素数 1 2 ~ 1 0 のジアリールアミノ基、置換もしくは無置換の核炭素数 1 2 ~ 1 0 のアリール基、置換もしくは無置換の核炭素

数 $3 \sim 4$ 0 のヘテロアリール基、又は置換もしくは無置換の核炭素数 $1.8 \sim 1.2$ 0 のジアリールアミノアリール基、 L^3 が、単結合及び

からなる群から選ばれる基である。)

一般式(C)のR'は、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 $6 \sim 60$ のアリール基、置換もしくは無置換の核炭素数 $3 \sim 60$ のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、又は置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 20$ のアルコキシ基である。

R の置換もしくは無置換のアリール基の例としては、前記Ar''と同様のものが挙げられる。

R"の置換もしくは無置換のヘテロアリール基の例としては、前記A r "と同様のものが挙げられる。

R"の置換もしくは無置換のアルキル基の例としては、前記 Ar^2 'と同様のものが挙げられる。

R¨の置換もしくは無置換のアルコキシ基の例としては、前記Ar²'と同様のものが挙げられる。

一般式(C)で表される化合物の具体例としては、以下の例示化合物等が挙げられるがこれら例示化合物に限定されるものではない。

 Ar^{1} L^{1} L^{2}

(C-1)

(C·2)

(C-3)

(C-5)

(C·6) (C·7) (C·7)

	Ar ¹	L ¹	L ²	Ar ²
(C·9)		`	Q	Ho
(C·10)		\	Q	
(C-11)		_		
(C·12)		\	Q	Han
(C·13)		_	Q	
(C·14)		_		
(C-15)	Q	. 🔪		
(C-16)		_		
(C-17)		_	Q	
(C-18)	Q	_		
(C-19)	Q	`		
(C-20)		`	Q	Paro

Ar¹

L¹

 L^2

Ar²

(C·21)

_

(C·22)

\

(C-23)

\

Q

fo

(C·24)

\

0

(C-25)

\

Q

(C-26)



. <

0

fa

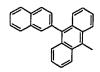
(C·27)



\

Q

(C·28)



\

Q

(C-29



\

Q

	Ar ¹	L ¹	L ²	Ar ^{2 II}
(C-30)			/	
(C·31)			. /	
(C-32)		\Diamond	/	
(C-33)			/	
(C-34)			/	
(C-35)			/	
(C-36)			/	
(C-37)			/	
(C·38)			/	
(C-39)				

また、一般式(C)で表される含窒素環化合物は置換基を有していてもよく、 置換基として好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、芳香族炭化 水素基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカ ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、 アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニ ルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチ オ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、より好 ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン 原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、さらに好ましくはアルキル基、アリー ル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族複素環基であり、特に好ましく はアルキル基、アリール基、アルコキシ基、芳香族複素環基である。

これらの含窒素環化合物は、エネルギーギャップが小さいので陰極からの電子 注入性に優れ、電子輸送に対する耐久性も高く、長寿命の素子を与えることがで きる。

本発明においては、還元性ドーパントが、前記電子注入層に添加されているか、又は陰極と該陰極と接合する層との界面領域に添加されていると好ましく、還元性ドーパントの仕事関数が、2.9 e V以下であると好ましい。この電子注入効率を上昇させる化合物と定義され。該還元性ドーパントは、含有される電子注入層又は界面領域の少なくとも一部を還元しアニオン化する。

界面領域への還元性ドーパントの添加形態としては、層状又は島状に形成する と好ましい。

この還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ金属錯体、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、アルカリ土類金属錯体、アルカリ土類金属化合物、希土類金属、希土類金属錯体、希土類金属化合物から選ばれた少なくとも一種類を用いると好ましい。前記アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、及び希土類金属化合物としては、それぞれの酸化物やハロゲン化物が挙げられる

前記アルカリ金属としては、Na(仕事関数:2.36 e V)、K(仕事関数:2.28 e V)、Rb(仕事関数:2.16 e V)、Cs(仕事関数:1.95 e V)等が挙げられ、仕事関数が 2.9 e V以下のものが特に好ましい。これらのうち好ましくはK、Rb、Cs、さらに好ましくはRb又はCsであり、最も好ましくはCsである。

前記アルカリ土類金属としては、Ca(仕事関数:2.9 e V)、Sr(仕事関数:2.0 \sim 2.5 e V)、Ba(仕事関数:2.5 2 e V)等が挙げられ、仕事関数が 2.9 e V以下のものが特に好ましい。

前記、希土類金属としては、Sc、Y、Ce、Tb、Yb等が挙げられ、仕事 関数が2.9eV以下のものが特に好ましい。

以上の金属のうち好ましい金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が可能である。

前記アルカリ金属化合物としては、Li₂O、Cs₂O、K₂O等のアルカリ酸化物、LiF、NaF、CsF、KF等のアルカリハロゲン化物等が挙げられ、LiF、Li₂O、NaFのアルカリ酸化物又はアルカリフッ化物が好ましい

前記アルカリ土類金属化合物としては、BaO、SrO、CaO及びこれらを混合したBa、Sr_{1-x} O(0 < x < 1) や、Ba、Ca_{1-x} O(0 < x < 1) 等が挙げられ、BaO、SrO、CaOが好ましい。

前記希土類金属化合物としては、YbF₃、ScF₃、ScO₃、Y₂O₃、Ce₂O₃、GdF₃、TbF₃等が挙げられ、YbF₃、ScF₃、TbF₃が好ましい。

前記アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体、希土類金属錯体としては、それぞれ金属イオンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類

金属イオンの少なくとも一つ含有するものであれば特に限定はない。また、配位子にはキノリノール、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、 β ージケトン類、アゾメチン類、及びそれらの誘導体などが好ましいが、これらに限定されるものではない。

形成方法としては、抵抗加熱蒸着法により還元性ドーパントを蒸着しながら、 界面領域を形成する発光材料や電子注入材料である有機物を同時に蒸着させ、有 機物中に還元ドーパントを分散する方法が好ましい。分散濃度としてはモル比で 有機物:還元性ドーパント=100:1~1:100、好ましくは5:1~1: 5である。

還元性ドーパントを層状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を層状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは層の厚み0.1~15 nmで形成する。

還元性ドーパントを島状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を島状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは島の厚み0.05~1nmで形成する。

また、本発明の有機 E L 素子の電子注入層における、主成分と還元性ドーパントの割合としては、モル比で主成分:還元性ドーパント = $5:1\sim1:5$ であると好ましく、 $2:1\sim1:2$ であるとさらに好ましい。

本発明の有機EL素子において、陰極と陽極間に、燐光性の発光材料が添加されている正孔輸送層を有すると好ましい。この正孔輸送層に用いる正孔輸送材料は、その三重項エネルギーが、前記発光層中の燐光性の発光材料の励起エネルギ

ーより大きいと好ましい。

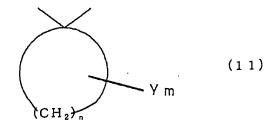
また、従来用いられてきた下記TPDやNPD

は、三重項エネルギーがそれぞ2.46 e V, 2.51 e Vであり、これに対し、本発明で用いる発光層中の燐光性の発光材料は、例えば前記した(K-10)の三重項エネルギーは2.55 e Vであるので、発光層の励起状態を失活してしまう。すなわち、正孔輸送材料の三重項エネルギーが2.55 e Vより大きいものが失活程度が小さく発光効率が高くなる。

本発明で用いる三重項エネルギーが 2.55eVより大きい正孔輸送材料の具体例としては、以下に示す一般式 (10)、 (12)、 (14) ~ (17) 及び (19) のものが好ましく、それらは縮合芳香族環を有しないことが好ましい。

[式中、nは $0 \sim 3$ の整数であり、 $R^1 \sim R^3$ は、それぞれ置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 3$ 0 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 3$ 0 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数 $6 \sim 3$ 0 のアリール基、置換もしくは無置換の核炭素数 $6 \sim 3$ 0 のアリールアルキル基である。B は、シクロヘキシレン、アダマンチルなどの脂肪族環残基であるが、好ましくは下記一般式(1 1)で

示される脂肪族環残基を表す。



(式中、Yは、置換もしくは未置換のアルキル基又は置換もしくは無置換のアリール基である。nは2~7の整数、mは0~2の整数を表す。)]

$$A - B - A \qquad (12)$$

[式中、Aは下記一般式(13)で表されるジアミン誘導体残基、Bはアダマンチル脂肪族環状基であり、好ましくは前記一般式(11)で示される脂肪族環残基をそれぞれ表す。]

[(式中、 $R^1 \sim R^9$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のチオアルコキシ基、シアノ基、アミノ基、モノ又はジ置換アミノ基、水酸基、メルカプト基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアリールチオ基、置換もしくは無置換の芳香族環基、置換もしくは無置換の複素環基を表し(ただし、 $R^1 \sim R^3$ 、 $R^4 \sim R^6$ 及び $R^7 \sim R^9$ のうち少なくとも1個は水素原子ではない。また、隣接した置換基同士で置換もしくは無置換の脂肪族式環、置換もしくは無置換の炭素環式芳香族環、置換もしくは無置換の複素環式芳香族環

基、置換もしくは無置換の複素環を形成しても良い。)、Xはフェニル、ビフェニルイル、又はターフェニルイルである。]

$$X \stackrel{Ar^1}{\longrightarrow} X$$

$$Ar^2 \stackrel{Ar^1}{\longrightarrow} X$$

$$Ar^2 \stackrel{Ar^1}{\longrightarrow} X$$

$$(15)$$

(式中、 Ar^1 、 Ar^2 は置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim18$ のアリール基であり、Rは、置換もしくは無置換の炭素数 $1\sim30$ のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基または核炭素数 $6\sim18$ のアリール基である。Xは単結合、アルキレン、-0-Xは-0-Xはので表される連結基を示し、Xはあってもなくてもよい。)で表されるジアミン化合物。

(式中、Ar' は置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim18$ のアリール基、Ar' $\sim Ar'$ は、それぞれ置換もしくは無置換の核炭素数 $6\sim18$ のアリーレン基を示し、X' は、単結合,-O-、-S-、アルキレンである連結基を示し、これらの連結基はあってもなくてもよく、X' 及びX' は、それぞれ単結合、-O-、-S-、アルキレン基を表し、それらは同一でも異なっていてもよい。〕で表されるトリアミン化合物。

$$R^{1}$$
 R^{5}
 R^{1}
 R^{10}
 R^{2}
 R^{10}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{1}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環基を表し、 R^1 と R^2 、 R^3 と R^4 、 R^5 と R^6 、 R^7 と R^8 、 R^9 と R^{10} 、 R^{11} と R^{12} は、それぞれ隣接する置換基同士で環を形成してもよい。

Xは以下に示す3価の連結基を表し、

Ar'は、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基、芳香族複素環基、又は、以下に示す一般式(18)で表される基である。

$$R^{13}$$
 R^{14}
 R^{15}
 R^{16}
 R^{18}
 R^{18}

(式中、R¹³~R¹⁸は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、置換もしくは無置換のアミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環基を表わし、R¹⁸とR¹⁴、R¹⁵とR¹⁶、R¹⁷とR¹⁸は、それぞれ隣接する置換基同士で環を形成してもよい。

(式中、Rは、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環基である。)

本発明の有機EL素子の素子構成としては、陽極/発光層/電子注入層/陰極、陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極、陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極等の構造が挙げられる。

本発明の有機EL素子は、電子注入層と陰極との間に絶縁体や半導体で構成される無機化合物層や電子輸送層を設けてもよい。これらの層は、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子輸送層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、LizO、LiO、NazS、NazSe、NaO等が挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、CaSeが挙げ

られる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiCl、KCl、NaCl等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、 CaF_2 、 BaF_2 、Sr F_2 、 MgF_2 、 BeF_2 等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

電子輸送層を構成する半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnの少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の一種単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子輸送層を構成する無機化合物が、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子輸送層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

正孔注入・輸送層は、発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常 5.5 eV以下と小さい。このような正孔注入・輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6 V/cm$ の電界印加時に、 $10^{-6} cm^2/V$ ・秒以上であるものが好ましく、 $10^{-5} cm^2/V$ ・秒以上であるものがさらに好ましい。

さらに、有機EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層又は発光層に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有すると効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が挙げられる。また、陰極としては、電子輸送層又は発光層に電子を注入するために、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極の材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マ

グネシウム、マグネシウムーインジウム合金、マグネシウムーアルミニウム合金 、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム合金、 マグネシウムー銀合金等が挙げられる。

本発明の有機EL素子における各層の形成方法は特に限定されず、従来公知の 真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本 発明の有機EL素子に用いる有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE 法)あるいは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で 形成することができる。

本発明の有機EL素子における各有機薄膜層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数nmからlμmの範囲が好ましい。

次に、実施例を用いて本発明をさらに詳しく説明すが、本発明はこれらに限定 されるものではない。

なお、化合物の三重項エネルギー、一重項エネルギー及びイオン化ポテンシャルは、以下のようにして測定した。

(1)三重項エネルギーの測定

最低励起三重項エネルギー準位T1を測定した。すなわち、試料の燐光スペクトルを測定し($10\mu mol/$ リットル EPA(ジエチルエーテル:イソペンタン:エタノール=5:5:2容積比)溶液、77K、石英セル、SPEX社FLUOROLOGII)、燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き横軸との交点である波長(発光端)を求めた。この波長をエネルギー値に換算した。

(2) 一重項エネルギー(エネルギーギャップ)の測定

励起一重項エネルギーの値を測定した。すなわち、試料のトルエン溶液(10 -5モル/リットル)を用い日立社製紫外可視吸光計を用い吸収スペクトルを測定した。スペクトルの長波長側の立ち上りに対し接線を引き横軸との交点である波長(吸収端)を求めた。この波長をエネルギー値に換算した。

(3) イオン化ポテンシャルの測定

理研計器社製、大気下光電子分光装置AC-1にて材料粉末を用い測定した。 実施例1

25 mm×75 mm×1. 1 mm厚のITO透明電極付きガラス基板 (ジオマ ティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、 UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸 着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に前記 透明電極を覆うようにして膜厚10nmの銅フタロシアニン膜(以下「CuPc 膜」と略記する。)を成膜した。このCuPc膜は、正孔注入層として機能する 。CuPc膜上に膜厚30nmの下記TPACを成膜した。このTPAC膜は正 孔輸送層として機能する。さらに、TPAC膜上に膜厚30nmの下記化合物P Bl02を蒸着し発光層を成膜した。同時に燐光性のIr金属錯体として前記(K-3)を添加した。(K-3)の濃度は発光層中7重量%である。この膜は、 発光層として機能する。この膜上に膜厚20nmのトリス(8-キノリノール) Al錯体(以下、Alqという)を設けた。このAlq膜は、電子注入層として 機能する。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAlqとを、モル比でAlq:Li=1:1で二元蒸着させ、陰極側の電子 注入層としてAlq:Li膜を10nm形成した。このAlq:Li膜上に金属 Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ (一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネ

ルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

比較例1(正孔輸送性発光層と正孔阻止層を用いた比較例)

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚10nmの銅フタロシアニン膜(以下「CuPc膜」と略記する。)を成膜した。このCuPc膜は、正孔注入層として機能する。CuPc膜の成膜に続けて、この膜上に膜厚30nmの前記NPDを成膜した。このNPD膜は正孔輸送層として機能する。さらに、NPD膜の成膜に続けて

膜上に膜厚30nmの正孔輸送性の下記CBPをホスト材料として蒸着し発光層を成膜した。同時に燐光性のIr金属錯体として前記(K-3)を添加した。(K-3)の濃度は発光層中7重量%であった。この膜は、発光層として機能する。この膜上に膜厚10nmの(1,1'ービスフェニル)ー4ーオラート)ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム(以下、BAlqという)を設けた。このBAlq膜は正孔阻止層として機能する。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAlqとを、モル比でAlq:Li源:サエスゲッター社製)とAlqとを、モル比でAlq:Li=1:1で二元蒸着させ、陰極側の電子注入層としてAlq:Li膜を10nm形成した。このAlq:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧7.2 Vで発光輝度9.8 c d/m²、発光効率3.2 c d/Aの青緑色発光が得られたが、実施例に比較して非常に低い発光効率であった。これは、発光層に正孔輸送性の化合物をホスト材料として用いたため、発光層の励起状態が失活し、消光しているためである。これらの結果を表1に示す。

比較例 2 (正孔輸送性発光層を用いた比較例)

実施例 1 において、発光層のホスト材料として、化合物 P B 1 0 2 の代わりに 正孔輸送性の前記 C B P を用いたこと以外は同様にして有機 E L 素子を作製した

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.8Vで発光輝度 $1.2cd/m^2$ 、発光効率 0.3cd/Aの青緑色発光しか得られず、発光効率が非常に低かった。これは、発光層に正孔輸送性の化合物をホスト材料として用いたため、発光層の励起状態が失活し、消光しているためである。また、比較例 1 と比較して、ある程度の発光効率を得るためには、正孔阻止層が必要であることも判明した。これらの結果を表 1 に示す。

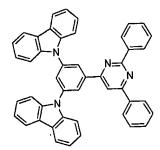
実施例2

実施例1において、発光層のホスト材料として、化合物PB102の代わりに

電子輸送性の下記PB115を用いたこと以外は同様にして有機BL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.5 V で発 光輝度 102 c d / m 2 、発光効率 14.8 c d / A の青緑色発光という極めて 高い効率が得られた。これらの結果を表 1 に示す。



PB115

実施例3

実施例1において、電子注入層を形成するAlq及びAlq:Liの代わりに前記BAlqを用い、BAlqの陰極側20nmにはLiを添加したこと以外は同様にして有機EL素子を作製した。この場合、発光層は電子注入層に直接接合し、さらにBAlq層に陰極が接合している。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネ ルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示 す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 7.8V で発 光輝度 9.3 c d 2 m 2 、発光効率 1.2 . 3 c d 2 A の青緑色発光という極めて高 い効率が得られた。これらの結果を表 1 に示す。

実施例 4

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極が形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚50nmの前記NPDを成膜した。このNPD膜は正孔輸送層として機能する。さらに、NPD膜上に膜厚30nmの電子輸送性の前記PB115をホスト材料として蒸着し発光層を成膜した。同時に燐光性のIr金属錯体として前記(K-10)を添加した。(K-10)の濃度は発光層中5重量%である。この膜は、発光層として機能する。この膜上に膜厚10nmのAlqを電子注入層として蒸着した。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAlqとを、モル比でAlq:Li=1:1で二元蒸着させ、陰極側の電子注入層としてAlq:Li膜を30nm形成した。このAlq:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネ ルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示 す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 4.5 V で発光輝度 620 c d / m 2 、発光効率 32.5 c d / A の緑色発光が得られた。これらの結果を表 1 に示す。

比較例3 (正孔輸送性発光層を用いた比較例)

実施例4において、発光層のホスト材料として、化合物PB115の代わりに 正孔輸送性の前記CBPを用いたこと以外は同様にして有機EL素子を作製した

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 5.1Vで発光輝度 $101cd/m^2$ 、発光効率 5.7cd/Aの緑色発光しか得られず、発光効率が低かった。これは、発光層に正孔輸送性の化合物をホスト材料として用いたため、発光層の励起状態が失活し、消光しているためである。これらの結果を表 1に示す。

比較例4 (イオン化ポテンシャルが5.9 e Vより大きいホスト材料を含む電子輸送性発光層を用いた比較例)

実施例4において、発光層のホスト材料として、化合物PB115の代わりに電子輸送性の下記BCPを用いたこと以外は同様にして有機EL素子を作製した

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.2 Vで発 光輝度 3 2 0 c d/m²、発光効率 3 0.2 c d/Aの緑色発光が得られ、発光

層の消光は免れている。しかし、実施例4の有機EL素子と同程度の発光効率を得るために、1.7 V高い電圧が必要であった。これは、BCPのイオン化ポテンシャルが高いため、正孔が注入できないためである。これらの結果を表1に示す。

BCP

実施例5

実施例 2 において、正孔輸送層の材料として、TPACの代わりに下記TCT Aを用い、燐光性のIr 金属錯体として (K-3) を添加したかわりに前記 (K-23) を用い、電子注入層中の電子輸送材料としてAIqの代わりに前記 (A-7) を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネ ルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示 す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.0 V で発光輝度 104 c d / m 2 、発光効率 20.8 c d / A の青緑色発光という極めて高い効率が得られた。これらの結果を表 1 に示す。

実施例6

実施例 5 において、電子注入層中の電子輸送材料として(A-7)の代わりに前記(C-15)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネ ルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示 す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.1V で発光輝度 105 c d / m 2 、発光効率 23.1 c d / A の青緑色発光という極めて高い効率が得られた。これらの結果を表 1 に示す。

比較例 5 (正孔輸送性発光層を用いた比較例)

実施例 5 において、発光層のホスト材料として、化合物PB115の代わりに 正孔輸送性の前記CBPを用いたこと以外は同様にして有機EL素子を作製した

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 6.3Vで発光輝度 $102cd/m^2$ 、発光効率 9.2cd/Aの青緑色発光しか得られず、実施例 5に比べ著しく発光効率が低かった。これは、発光層に正孔輸送性の化合物をホスト材料として用いたため、発光層の励起状態が失活し、消光しているためである。これらの結果を表 1に示す。

比較例 6 (イオン化ポテンシャルが 5.9 e Vより大きいホスト材料を含む電子輸送性発光層を用いた比較例)

実施例 5 において、発光層のホスト材料として、化合物 PB115 の代わりに電子輸送性の下記 TPBI(2,2',2''-(1,3,5-フェニレン) トリス [1-フェニル-1H-ベンズイミダゾール]:特開平 10-106749 号公報に合成法記載)を用いたこと以外は同様にして有機 EL 素子を作製した。

発光層中のホスト材料の種類、イオン化ポテンシャル、エネルギーギャップ(一重項エネルギー)及び三重項エネルギー、発光層中の燐光性の発光材料(金属 錯体)の種類及び三重項エネルギー、電子注入層中の電子輸送材料の種類、エネルギーギャップ及び三重項エネルギーの値、並びに正孔輸送層の材料を表1に示す。

また、得られた素子について、特性を評価したところ、直流電圧 7. 6 V で発光輝度 1 0 2 c d / m 2 、発光効率 1 4 . 6 c d / Aの青緑色発光が得られ、発光層の消光は免れている。しかし、実施例 5 の有機 E L 素子と同程度の発光効率を得るために、 1 . 6 V も高い電圧が必要であった。これは、T P B I のイオン化ポテンシャルが高いため、正孔が注入されにくいためである。これらの結果を表1 に示す。

TPB I

7 1

	Į			路米田	?	青緑色	青緑色	骨綠色	敬	青緑色	育緑色	黎	敬	青緑色	臂綠色	臂綠色	音級布) ;
	語をせる	6 彼れ 米ナツ 特 注 評値		光沙率	(cd/A)	1	14.8	12.3	32.5	3.2	0.3	5.7	30.2	20.8	23.1	9.2	14.6	1
	一番に対する	が成じて来っ		光光輝度	(cd/m ²)	89	102	93	620	86	1.2	101	320	104	105	102	102	
	7	4-		明田	2	9.9	6.5	7.8	4.5	7.2	6.8	5.1	6.2	6.0	6.1	6.3	7.6	
0 × 44 × 1	止 允糟 下		下了輸送材	料の種類		TPAC	TPAC	TPAC	TPAC.	TPAC	TPAC	TPAC	TPAC	TCTA	TCTA	TCTA	TCTA	
	~	型	工即專二	ネルギー	(Ae)	2.51	2.51	不明	2.51	不明	不思	2.51	2.51	2.7	2.74	2.7	2.7	
明りたり部	單十汪人陷	電子輸送材料	エネルギー	おからと	(eV)	2.7	2.7	2.85	2.7	2.85	2.85	2.7	2.7	2.97	3.04	2.97	2.97	
		地田		種類	<u></u>	Alq	Alq	BAlq	Alq	BAlq	BAlq	Alq	Alq	(A-7)	(C-12)	(4-A)	(A-7)	
		燐光性金屬錯体	三番項工	ネルギー	(eV)	2.76	2.76	2.76	2.55	2.76	2.76	2.55	2.55	2.75	2.75	2.75	2.75	
		婚光性		種類		Х Н3	K-3	K-3	K-10	K-3	K-3	K-10	K-10	K-23	K-23	K - 23	K-23	
Œ			工動事三	ネルギー	(A)	2.81	2.9	2.81	2.9	2.81	2.81	2.81	2.69	2.9	2.9	2.81	2.8	
图亦茶		ホスト材料	エネルギー	ギャップ	(eV)	3.48	3.2	3.48	3.2	3.56	3.56	3.56	3.5	3.2	3.2	3.56	4	圈
		ホス	イオン化ポーエネル	テンシャル ギャップ	(eV)	5.74	5.71	5.74	5.71	5.86	5.86	5.86	6.4	5.71	5.71	5.86	6.7	※比較例1のBAIaは正孔阻止層
				種類		PB102	PB115	PB102	PB115	GBP	CBP	CBP	ВСР	PB115	PB115	CBP	TPBI	10BAlq
						実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	実施例5	実施例6 PB115	比較例5	比較例6	※比較例

72

表1に示したように、実施例1~6の有機EL素子において、発光層中のホスト材料のエネルギーギャップは電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップより大きいのでエネルギー移動が生じ、励起状態が消光する可能性がある。また、発光層中のホスト材料の三重項エネルギー及び金属錯体の三重項エネルギーは、電子注入層中の電子輸送材料の三重項エネルギーより大きいのでエネルギー移動が生じ、励起状態が消光する可能性もある。しかし、電子輸送性の発光層を用いたことにより、高発光効率が可能になった。

また、実施例 4 と比較例 4、及び実施例 5 と比較例 6 をそれぞれ比べると、発 光層中のホスト材料のイオン化ポテンシャルが小さいので、低電圧駆動が可能に なることが判明した。

これらに対し、比較例 1 ~ 3 及び比較例 5 の素子は励起状態が消光していることを示し、発光効率が低い。

産業上の利用可能性

以上詳細に説明したように、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、 素子を構成する発光層及び電子注入層が特定の条件を満たし、電子輸送性の発光 層を用いているため、燐光性の発光を用い、発光効率が高い。このため、フルカ ラー用の有機エレクトロルミネッセンス素子として有用である。

請求の範囲

1. 陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光 層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層と陰極との間に 、発光層と接合した電子注入層を有し、

発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが 5.9eV以下であり、

電子注入層中の電子輸送材料のエネルギーギャップが、発光層中のホスト材料 のエネルギーギャップより小さいことを特徴とする有機エレクトロルミネッセン ス素子。

2. 陰極と陽極間に、少なくとも燐光性の発光材料とホスト材料からなる発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層と陰極との間に、発光層と接合した電子注入層を有し、

発光層が電子輸送性で、前記ホスト材料のイオン化ポテンシャルが 5.9eV以下であり、

電子注入層中の電子輸送材料の三重項エネルギーが、発光層中のホスト材料の 三重項エネルギーより小さいことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素 子。

- 3. 還元性ドーパントが、電子注入層に添加されているか、又は陰極と該陰極と接合する層との界面領域に添加されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 4. 陰極と陽極間に、燐光性の発光材料が添加されている正孔輸送層を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 5. 前記正孔輸送層中の正孔輸送材料の三重項エネルギーが、発光層中の燐光性の発光材料の励起エネルギーより大きいことを特徴とする請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

6. 前記発光層中のホスト材料が電子輸送性である請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 7. 前記発光層中のホスト材料の電子輸送度が 10^{-6} c m² /V s 以上である請求項6 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 8. 前記電子輸送材料が、単一種の含窒素環誘導体が配位した金属錯体である請求項1又は2のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 9. 前記含窒素環が、キノリン、フェニルピリジン、ベンゾキノリン又はフェナントロリンである請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 10. 前記金属錯体が、キノリノールの金属錯体又はその誘導体である請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 11. 前記電子輸送材料が、含窒素環と縮合芳香族環が連結した化合物、又は含窒素環がアリーレン基を介して縮合芳香族環と連結した化合物(含窒素環、縮合芳香族環及びアリーレン基は、それぞれ置換基を有していてもよい)である請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 12. 前記縮合芳香族環が、ナフタレン、アントラセン、ピレン、フェナントレン、フルオランテン、クリセン、ペリレン、ナフタセン又はペンタセンである請求項11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 13. 前記含窒素環が、6員環と5員環の縮合環であり、1~4個の窒素原子を有する請求項11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 14. 前記ホスト材料が、カルバゾリル基もしくはアザカルバゾリル基が含窒素環に連結した化合物、又はカルバゾリル基もしくはアザカルバゾリル基がアリーレン基を介して含窒素環に連結した化合物(カルバゾリル基、アザカルバゾリル基、含窒素環及びアリーレン基は、それぞれ置換基を有していてもよい)である請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 15. 前記含窒素環が、ピリジン、キノリン、ピラジン、ピリミジン、キノキサリン、トリアジン、イミダゾール、イミダゾピリジン、ピリダジン又はベンズ

イミダゾールである請求項14に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/12598

							
	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05B33/22, H05B33/14						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ntional classification and IPC					
	S SEARCHED						
Int.	ocumentation searched (classification system followed l C1 ⁷ H05B33/00-33/28						
Jitsu Kokai	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1922–1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho Toroku Jitsuyo Shinan Koho	o 1996–2003 o 1994–2003				
	ata base consulted during the international search (name OG (WPI), AIP Online Journal, W		rch terms used)				
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
P,X	JP 2002-352957 A (Honda Moto 06 December, 2002 (06.12.02), Claims; Par. Nos. [0119] to (Family: none)	,	1,6-10				
P,X	JP 2003-77673 A (Honda Motor 14 March, 2003 (14.03.03), Par. Nos. [0123] to [0130] (Family: none)	Co., Ltd.),	1,6-10				
A	JP 2002-151267 A (Fuji Photo 24 May, 2002 (24.05.02), Claims (Family: none)	Film Co., Ltd.),	1-15				
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 28 October, 2003 (28.10.03)							
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer					
Japa Faccimile N	nese Patent Office	Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/12598

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP 2002-56976 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 22 February, 2002 (22.02.02), (Family: none)	1-15
A	WO 02/51206 A (THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY), 27 June, 2002 (27.06.02), & US 2002/0113545 A1 & AU 200229047 A & TW 524027 A	1-15
A .	ADACHI, BALDO et al., "Nearly 100% internal phosphorescence efficiency in an organic light emitting device", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol.90, No.10, pages 5048 to 5051, (2001)	. 1
A	JP 8-319482 A (Philips Electronics N.V.), 03 December, 1996 (03.12.96), & EP 697744 A & US 5756224 A	2
A .	WO 01/72927 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 04 October, 2001 (04.10.01), & US 2002/0045061 A1 & EP 1205527 A & KR 2002026866 A & CN 1365381 A	3
A .	WO 02/071813 A (THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY), 12 September, 2002 (12.09.02), © US 2002/0180347 A1	4

			
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. (C1' H05B33/22, H05B33	1 4	
B. 調査を			
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. (C1' H05B33/00-33/28		
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	用新案公報 1922-1996年		
日本国公	開実用新案公報 1971-2003年		
日本国実	用新案登録公報 1996-2003年 録実用新案公報 1994-2003年		
日本国登	録実用		
DIAI	用した電子データベース(データベースの名称、 LOG(WPI)	、	
AIP Web	Online Journal of Science		
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		関連する
<i>D</i> - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
P, X	JP 2002-352957 A	(本田技研工業株式会社)	1, 6-10
	2002. 12. 06,		
	特許請求の範囲,【0119】-【	0 1 2 9]	
	(ファミリーなし)		
P, X	JP 2003-77673 A (本田技研工業株式会社)	1, 6-10
	2003.03.14, [0123]	 - [0130]	
	(ファミリーなし)		
[F2] 10n 4.5.			
区欄の続き	をにも文献が列挙されている。 	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
	ロカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの 「ア・〒1994年出席		出願と矛盾するものではなく、列	を明の原理又は理論
	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日 ☆表されたもの	の理解のために引用するもの	N=1-1-1-1
	はなされたもの E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、≧ の新規性又は進歩性がないと考え	
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当	
文献(理	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	明である組合せに
「〇」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	560
「P」国際出席	質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了	した日	国際調査報告の発送日	
	28.10.03	18.11.0	13
	A Cliff with a th		<u> </u>
	0名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	2V 9529
	8世紀 (15 A/) P) 8便番号 100 - 89 15	今関 雅子 (門門))
	B千代田区霞が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101	内線 3271
			гл <i>я</i> к Э <i>2</i> (1.

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-151267 A (富士写真フィルム株式会社) 2002.05.24,特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-15
A	JP 2002-56976 A (富士写真フィルム株式会社) 2002.02.22 (ファミリーなし)	1-15
A	WO 02/51206 A (THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY) 2002. 06. 27 &US 2002/0113545 A1 &AU 200229047 A &TW 524027 A	1-15
A	ADACHI, BALDO et.al, "Nearly 100% internal phosphorescence efficiency in an organic light emitting device" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 90, No. 10, pp. 5048-5051 (2001)	1
A	JP 8-319482 A (フィリップス エレクトロニクス ネムローセ゚ フェンノートシャップ) 1996. 12. 03 &EP 697744 A &US 5756224 A	2
A	WO 01/72927 A (出光興産株式会社) 2001.10.04 &US 2002/0045061 A1 &EP 1205527 A &KR 2002026866 A &CN 1365381 A	3
A	WO 02/071813 A (THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY) 2002. 09. 12 &US 2002/0180347 A1	4